

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА"**

СОГЛАСОВАНО
Зав. выпускающей кафедры

УТВЕРЖДАЮ

Физика твердого тела
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Микро- и наноэлектроники
Учебный план	03.03.01_26_00.plx 03.03.01 Прикладные математика и физика
Квалификация	бакалавр
Форма обучения	очная
Общая трудоемкость	6 ЗЕТ

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	5 (3.1)		Итого	
Неделя	16			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Лабораторные	16	16	16	16
Практические	16	16	16	16
Иная контактная работа	0,35	0,35	0,35	0,35
Консультирование перед экзаменом и практикой	2	2	2	2
Итого ауд.	66,35	66,35	66,35	66,35
Контактная работа	66,35	66,35	66,35	66,35
Сам. работа	96	96	96	96
Часы на контроль	53,65	53,65	53,65	53,65
Итого	216	216	216	216

г. Рязань

Программу составил(и):

к.ф.-м.н., доцент, Мишустин Владислав Геннадьевич

Рабочая программа дисциплины

Физика твердого тела

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

ФГОС ВО - бакалавриат по направлению подготовки 03.03.01 Прикладные математика и физика (приказ Минобрнауки России от 07.08.2020 г. № 890)

составлена на основании учебного плана:

03.03.01 Прикладные математика и физика

утвержденного учёным советом вуза от 24.04.2026 протокол № 10.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Микро- и нанoeлектроники

Протокол от 15.05.2026 г. № 5

Срок действия программы: 2026 - 2030 уч.г.

Зав. кафедрой Литвинов Владимир Георгиевич

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2027-2028 учебном году на заседании кафедры
Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2028-2029 учебном году на заседании кафедры
Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2029-2030 учебном году на заседании кафедры
Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2030-2031 учебном году на заседании кафедры

Микро- и нанoeлектроники

Протокол от ____ 2030 г. № ____

Зав. кафедрой _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1	Целью освоения дисциплины является формирование базовых знаний и умений в области физики твердого тела в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, формирование у студентов способности к логическому мышлению, анализу и восприятию информации, формирование навыков инженерной работы, посредством обеспечения этапов формирования компетенций, предусмотренных ФГОС, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2	Задачи:
1.3	- формирование представлений о физической сущности процессов, протекающих в твердых телах (кристаллах) и приборных структурах на их основе;
1.4	- обучение представлениям обоснованных теоретических моделей физики твердого тела с четким
1.5	определением границ, в пределах которых справедливы соответствующие физические концепции, модели, теории;
1.6	- обучение физическим принципам работы некоторых устройств твердотельной электроники;
1.7	- формирование навыков и умений исследовательской и инженерной работы;
1.8	- обучение методам обработки и анализа результатов лабораторных экспериментов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:		Б1.О
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:	
2.1.1	Математика	
2.1.2	Метрология, стандартизация и сертификация	
2.1.3	Статистическая физика электронных процессов	
2.1.4	Теоретические основы электротехники	
2.1.5	Физические основы электроники	
2.1.6	Ознакомительная практика	
2.1.7	Учебная практика	
2.1.8	Физика	
2.1.9	Учебная практика (ознакомительная)	
2.1.10	Химия	
2.2	Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:	
2.2.1	Производственная практика	
2.2.2	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы	
2.2.3	Преддипломная практика	
2.2.4	Производственная практика	

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен применять фундаментальные знания, полученные в области физико-математических и (или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности, в том числе в сфере педагогической деятельности

ОПК-1.1. Применяет фундаментальные знания, полученные в области физико-математических наук и использует их в профессиональной деятельности, в том числе в сфере педагогической деятельности

Знать
фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы.

Уметь
применять фундаментальные законы природы и основные физические и математические законы.

Владеть
навыками использования фундаментальных законов природы и основных физических и математических законов.

ОПК-1.2. Применяет фундаментальные знания, полученные в области естественных наук, и использует их в профессиональной деятельности, в том числе в сфере педагогической деятельности

Знать физические законы и математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера.
Уметь применять физические законы и математические методы для решения задач теоретического и прикладного характера.
Владеть навыками использования физических законов и математических методов для решения задач теоретического и прикладного характера.

ОПК-3: Способен составлять и оформлять научные и (или) технические (технологические, инновационные) отчеты (публикации, проекты)

ОПК-3.1. Составляет научные и (или) технические (технологические, инновационные) отчеты (публикации, проекты)
Знать основные требования к структуре и оформлению отчетных материалов в области твердотельной электроники.
Уметь систематизировать и анализировать экспериментальные и теоретические данные для включения в отчетные материалы.
Владеть навыками составления отчетных материалов в области твердотельной электроники.
ОПК-3.2. Оформляет научные и (или) технические (технологические, инновационные) отчеты (публикации, проекты)
Знать требования ГОСТ, правила оформления научных текстов (цели и задачи, методика, результаты, выводы) и графических материалов (схемы, графики).
Уметь составлять технические отчеты по результатам экспериментальных исследований и оформлять техническую документацию.
Владеть навыками составления отчетных материалов и методами визуализации экспериментальных данных.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	базовые концепции и модели общей физики, физики полупроводников, квантовой физики, статистической физики, химии, метрологии.
3.2	Уметь:
3.2.1	применять на практике основные приемы и программные средства обработки и представления данных в соответствии с задачей исследования характеристик и параметров материалов и структур твердотельной электроники.
3.3	Владеть:
3.3.1	начальными навыками экспериментального исследования параметров и характеристик материалов и структур твердотельной электроники.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Форма контроля
	Раздел 1. Введение.					
1.1	Введение в дисциплину. /Тема/	5	0			
1.2	Введение в дисциплину «Физика твердого тела». Основные этапы развития, связь с другими дисциплинами направления «Электроника и наноэлектроника» /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	

	Раздел 2. Основные приближения зонной теории твердого тела.					
2.1	Основные приближения зонной теории твердого тела. /Тема/	5	0			
2.2	Основные приближения зонной теории твердого тела. Особенности энергетического спектра электрона в кристалле. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
2.3	Понятие эффективной массы; особенности классического и квантовомеханического описания электронного газа в полупроводниках и металлах. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
2.4	Исследование зависимости электропроводности полупроводниковых материалов от температуры и освещения. /Лаб/	5	4	ОПК-1.1-В ОПК-1.2-В ОПК-3.1-В ОПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
2.5	Строение и структура твердых тел. Основы квантовой механики и статистической физики. /Пр/	5	4	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
2.6	Основные приближения зонной теории твердого тела. /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 3. Собственные и примесные полупроводники.					
3.1	Собственные и примесные полупроводники. /Тема/	5	0			

3.2	Собственные и примесные полупроводники. Типы и роль примесей в полупроводниках. Методы расчета положения уровня Ферми в полупроводнике. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-З ОПК-1.2-З ОПК-3.1-З ОПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
3.3	Особенности температурной зависимости концентрации носителей заряда, основные эффекты, проявляющиеся при высоком уровне легирования; вырожденные полупроводники. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-З ОПК-1.2-З ОПК-3.1-З ОПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
3.4	Измерение вольт-амперных характеристик и вольт-фарадных характеристик полупроводниковых барьерных структур (диод Шоттки, р-п переход). /Лаб/	5	4	ОПК-1.1-В ОПК-1.2-В ОПК-3.1-В ОПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
3.5	Расчет концентрации носителей заряда в собственных и примесных полупроводниках. закон действующих масс. Зависимость концентрации свободных носителей заряда и положения уровня ферми в полупроводниках от температуры. /Пр/	5	4	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э2 Э7	
3.6	Собственные и примесные полупроводники. /Ср/	5	10	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 4. Кинетические явления в твердых телах.					
4.1	Кинетические явления в твердых телах. /Тема/	5	0			
4.2	Кинетические явления в твердых телах. Неравновесные явления в полупроводниках. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-З ОПК-1.2-З ОПК-3.1-З ОПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	

4.3	Основные механизмы рассеяния носителей заряда, подвижность. Тепловые колебания атомов кристаллической решетки. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-З ОПК-1.2-З ОПК-3.1-З ОПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
4.4	Измерение диффузионной длины и времени жизни носителей заряда в полупроводниках. /Лаб/	5	4	ОПК-1.1-В ОПК-1.2-В ОПК-3.1-В ОПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
4.5	Кинетические явления в твердых телах. /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 5. Процессы переноса в металлах.					
5.1	Процессы переноса в металлах. /Тема/	5	0			
5.2	Процессы переноса в металлах. Типичные свойства металлов. Функция Ферми. Электропроводность металлов, зависимость от температуры. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-З ОПК-1.2-З ОПК-3.1-З ОПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
5.3	Процессы переноса в металлах. /Ср/	5	10	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 6. Кинетические явления в полупроводниках.					
6.1	Кинетические явления в полупроводниках. /Тема/	5	0			

6.2	Кинетические явления в полупроводниках. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-З ОПК-1.2-З ОПК-3.1-З ОПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
6.3	Кинетические явления в твердых телах. /Пр/	5	4	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э2 Э7	
6.4	Кинетические явления в полупроводниках. /Ср/	5	10	ОПК-1.1-З ОПК-1.1-У ОПК-1.2-З ОПК-1.2-У ОПК-3.1-З ОПК-3.1-У ОПК-3.2-З ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 7. Оптические явления в твердых телах.					
7.1	Оптические явления в твердых телах. /Тема/	5	0			
7.2	Оптические явления в твердых телах. Межзонные электронные переходы. Экситонные эффекты. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-З ОПК-1.2-З ОПК-3.1-З ОПК-3.2-З	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
7.3	Оптические явления в твердых телах. /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 8. Явления в сильных электрических полях.					
8.1	Явления в сильных электрических полях. /Тема/	5	0			

8.2	Явления в сильных электрических полях. Понятие сильного поля. Эффект Френкеля-Пула. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
8.3	Явления в сильных электрических полях. /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 9. Контактные и поверхностные явления в твердых телах.					
9.1	Контактные и поверхностные явления в твердых телах. /Тема/	5	0			
9.2	Понятия работы выхода, контактной разности потенциалов, зонные диаграммы и вольтамперные характеристики контакта металл-полупроводник и р-п- перехода. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
9.3	Омические контакты. Гетеропереходы. Природа и свойства поверхностных состояний. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
9.4	Поверхностная проводимость. Эффект поля и вольт-фарадные характеристики МДП-структур. /Лек/	5	2	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
9.5	Изучение термоэлектрических и гальвано-магнитных эффектов в полупроводниках (изучение температурной зависимости термо-ЭДС, изучение эффекта Холла). /Лаб/	5	4	ОПК-1.1-В ОПК-1.2-В ОПК-3.1-В ОПК-3.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	

9.6	Контактные явления в твердых телах. /Пр/	5	4	ОПК-1.1-У ОПК-1.1-В ОПК-1.2-У ОПК-1.2-В	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э2 Э7	
9.7	Контактные и поверхностные явления в твердых телах. /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 10. Сверхпроводимость.					
10.1	Сверхпроводимость. /Тема/	5	0			
10.2	Сверхпроводимость. Критическая температура. Сверхпроводники I и II рода. Высокотемпературные сверхпроводники. Высокотемпературная сверхпроводимость. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
10.3	Сверхпроводимость. /Ср/	5	8	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 11. Неупорядоченные твердые тела.					
11.1	Неупорядоченные твердые тела. /Тема/	5	0			
11.2	Неупорядоченные твердые тела. Ближний и дальний порядок. Энергетические состояния электронов в неупорядоченных твердых телах. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
11.3	Плотность состояний. Локализация Андерсона. Переход Андерсона. Порог подвижности. Хвосты плотности состояний. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	

11.4	Неупорядоченные твердые тела. /Ср/	5	8	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 12. Особенности жидкого состояния вещества.					
12.1	Особенности жидкого состояния вещества. /Тема/	5	0			
12.2	Особенности жидкого состояния вещества. Жидкость как агрегатное состояние вещества. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
12.3	Тепловое движение частиц в жидкостях. Квантовые жидкости. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
12.4	Особенности жидкого состояния вещества. /Ср/	5	6	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 13. Вещества, сочетающие порядок и беспорядок.					
13.1	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок. /Тема/	5	0			
13.2	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок. Сильно легированные полупроводники, жидкие кристаллы. /Лек/	5	1	ОПК-1.2-3 ОПК-1.2-У ОПК-3.2-3 ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	

13.3	Вещества, сочетающие порядок и беспорядок. /Ср/	5	6	ОПК-3.2-3 ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 14. Наноматериалы и нанотехнологии.					
14.1	Наноматериалы и нанотехнологии. /Тема/	5	0			
14.2	Наноматериалы и нанотехнологии. Перспективы и тенденции разработки современных технологий и материалов. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
14.3	Наноматериалы и нанотехнологии. /Ср/	5	8	ОПК-1.1-У ОПК-1.2-У ОПК-3.1-У ОПК-3.2-У	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 15. Заключение.					
15.1	Заключение. /Тема/	5	0			
15.2	Заключение. Обобщение современных достижений и анализ проблем в области физических основ микро- и нанoeлектроники. /Лек/	5	1	ОПК-1.1-3 ОПК-1.2-3 ОПК-3.1-3 ОПК-3.2-3	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
	Раздел 16. Подготовка к аттестации, иная контактная работа.					
16.1	Подготовка к аттестации, иная контактная работа. /Тема/	5	0			
16.2	Подготовка к экзамену. /Экзамен/	5	53,65		Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3 Л2.4Л3.1 Л3.2 Л3.3 Л3.4 Л3.5 Л3.6 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	
16.3	Консультация перед экзаменом. /Кнс/	5	2			
16.4	Прием экзамена. /ИКР/	5	0,35			

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Оценочные материалы приведены в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Оценочные материалы по дисциплине "Физика твердого тела"").

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**6.1. Рекомендуемая литература****6.1.1. Основная литература**

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
Л1.1	Гуртов В. А., Осауленко Р. Н., Алешина Л. А.	Физика твердого тела для инженеров : учебное пособие	Москва: Техносфера, 2012, 560 с.	978-5-94836-327-1, http://www.iprbookshop.ru/26903.html
Л1.2	Ансельм А.И.	Введение в теорию полупроводников : Учеб.пособие	СПб.:Лань, 2008, 618с.	978-5-8114-0762-0, 1
Л1.3	Епифанов Г.И.	Физика твердого тела : учеб. пособие	СПб.: Лань, 2011, 288с.	978-5-8114-1001-9, 1
Л1.4	Байков Ю.А., Кузнецов В.М.	Физика конденсированного состояния : учеб. пособие	М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011, 293с.	978-5-9963-0290-1, 1

6.1.2. Дополнительная литература

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
Л2.1	Анфимов И. М., Кобелева С. П., Щемеров И. В.	Физика конденсированного состояния. Электронная структура твердых тел : лабораторный практикум	Москва: Издательский Дом МИСиС, 2014, 76 с.	978-5-87623-724-8, http://www.iprbookshop.ru/56588.html
Л2.2	Вихров С. П., Вишняков Н. В., Мишустин В. Г.	Физические процессы в барьерных структурах на основе неупорядоченных полупроводников : учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019, 75 с.	978-5-4487-0364-5, http://www.iprbookshop.ru/79688.html
Л2.3	Вихров С. П., Холомина Т. А.	Свойства и применение металлов и полупроводников : учебное пособие	Саратов: Вузовское образование, 2019, 80 с.	978-5-4487-0365-2, http://www.iprbookshop.ru/79791.html
Л2.4	Айвазов А.А., Будагян Б.Г., Вихров С.П., Попов А.И.	Неупорядоченные полупроводники : Учеб.пособие для вузов	М.МЭИ:Высш. шк., 1995, 352с.	5-7046-0142-1, 1

6.1.3. Методические разработки

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
---	---------------------	----------	-------------------	-------------------------

№	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Количество/название ЭБС
ЛЗ.1	Холомина Т.А., Евдокимова Е.Н.	Подготовка студентов к текущему и промежуточному контролю освоения компетенций : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2016,	, https://elib.rsreu.ru/ebs/download/1295
ЛЗ.2	Мальченко С.И., Мишустин В.Г., Тимофеев В.Н.	Материалы и компоненты радиоэлектронных средств : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2012,	, https://elib.rsreu.ru/ebs/download/1638
ЛЗ.3	Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А.	Исследование диода Шоттки методом вольт-фарадных характеристик : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2019,	, https://elib.rsreu.ru/ebs/download/2111
ЛЗ.4	Литвинов В.Г., Мишустин В.Г., Холомина Т.А.	Изучение температурной зависимости термо-ЭДС в полупроводниках : Методические указания	Рязань: РИЦ РГРТУ, 2019,	, https://elib.rsreu.ru/ebs/download/2112
ЛЗ.5	Холомина Т.А., Ампилогов В.Н., Кобцева Ю.Н., Лабутин А.В., Литвинов В.Г.	Физика твердого тела : Метод.указ.к лаб.раб.	Рязань, 2002, 96с.	, 1
ЛЗ.6	Авачев А.П., Воробьева Ю.В., Мишустин В.Г., Фомин П.А.	Физико-химические основы технологических процессов микро- и нанoeлектроники : метод. указ. к лаб. работам	Рязань, 2011, 48с.	, 1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Сайт кафедры микро- и нанoeлектроники РГРТУ
Э2	Система дистанционного обучения ФГБОУ ВО «РГРТУ»
Э3	Единое окно доступа к образовательным ресурсам
Э4	Интернет Университет Информационных Технологий
Э5	Электронно-библиотечная система «IPRbooks»
Э6	Электронно-библиотечная система издательства «Лань»
Э7	Электронная библиотека РГРТУ

6.3 Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства

Наименование	Описание
Операционная система Windows	Коммерческая лицензия
Kaspersky Endpoint Security	Коммерческая лицензия
Adobe Acrobat Reader	Свободное ПО
LibreOffice	Свободное ПО
Операционная система Windows XP	Microsoft Imagine, номер подписки 700102019, бессрочно
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»	Коммерческая лицензия
NI LabView	Лицензия для образовательных учреждений

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Система КонсультантПлюс http://www.consultant.ru
---------	---

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1	341 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория, оснащенная лабораторным оборудованием столы лабораторные (22 шт.), доска магнитно-маркерная, экран настенный, 5 компьютеров, блок питания ВИП-01 0(3 шт.), вольтметры В7-21А (3 шт.), В7-21, В7-35 (3 шт.), осциллографы С1-64А (3 шт.), С1-75, измерители Е4-7, Е9-4
2	404 учебно-административный корпус. Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного и семинарского типа, практических занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации Специализированная мебель (120 мест), мультимедийное оборудование, экран, компьютер, доска.
3	57 учебно-административный корпус. Учебная лаборатория для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, лабораторных работ текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная лабораторным оборудованием 20 мест, мультимедиа проектор Aser X128H, доска магнитно-маркерная, компьютер, 8 лабораторных столов, 3 компьютера, блоки питания ВИП-009 (7 шт.), ВИП-010(4 шт.), вольтметры В7-21(4 шт.), В7-21А(3 шт.), Ф283, генераторы Г4-165, Г4-81, Г6-27, измеритель Л2-56, лазер ЛГИ-502, осциллографы С1-65, С1-76
4	343 учебно-административный корпус. Учебно-вспомогательная Аудитория для хранения и ремонта оборудования 2 компьютера, принтер, сканер, 5 мест

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Методическое обеспечение дисциплины приведено в приложении к рабочей программе дисциплины (см. документ "Методические указания по дисциплине "Физика твердого тела").

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир
Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

07.07.26 14:51 (MSK)

Простая подпись

ПОДПИСАНО
ЗАВЕДУЮЩИМ
ВЫПУСКАЮЩЕЙ
КАФЕДРЫ

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Литвинов Владимир
Георгиевич, Заведующий кафедрой МНЭЛ

07.07.26 14:51 (MSK)

Простая подпись